



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2010-0090538
(43) 공개일자 2010년08월16일

(51) Int. Cl.

G02F 1/133 (2006.01) H01L 29/786 (2006.01)

(21) 출원번호 10-2009-0009879

(22) 출원일자 2009년02월06일

심사청구일자 없음

(71) 출원인

동우 화인켐 주식회사

전북 익산시 신흥동 740-30호

(72) 발명자

최용석

서울특별시 서대문구 남가좌1동 289-3

이석

전라북도 전주시 덕진구 호성동1가 동아아파트
104동 1801호

(뒷면에 계속)

(74) 대리인

한양특허법인

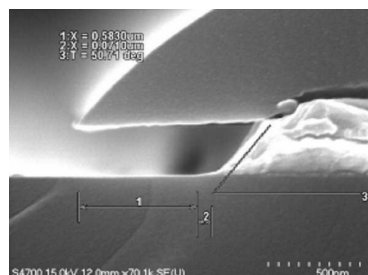
전체 청구항 수 : 총 14 항

(54) 액정표시장치용 어레이 기판의 제조방법

(57) 요약

본 발명은 a)기판 상에 게이트 배선을 형성하는 단계; b)상기 게이트 배선을 포함한 기판 상에 게이트 절연층을 형성하는 단계; c)상기 게이트 절연층 상에 반도체층을 형성하는 단계; d)상기 반도체층 상에 소스 및 드레인 전극을 형성하는 단계; 및 e)상기 드레인 전극에 연결된 화소전극을 형성하는 단계를 포함하는 액정표시장치용 어레이 기판의 제조방법에 있어서, 상기 a)단계는 기판 상에 구리계 금속막을 형성하고 상기 구리계 금속막을 식각액 조성물로 식각하여 게이트 배선을 형성하는 단계를 포함하고, 상기 d)단계는 구리계 금속막을 형성하고 상기 구리계 금속막을 식각액 조성물로 식각하여 소스 및 드레인 전극을 형성하는 단계를 포함하고, 상기 식각액 조성물은, 조성물 총 중량에 대하여 A)과산화수소(H_2O_2) 5 내지 25 중량%, B)유기산 0.1 내지 5 중량%, C)인산염 화합물 0.1 내지 5 중량%, D)수용성 시클릭 아민 화합물 0.1 내지 5 중량%, E)한 분자 내에 질소원자와 카르복실기를 갖는 수용성 화합물 0.1 내지 5 중량%, F)함불소 화합물 0.01 내지 1.0 중량%, G)다가알코올형 계면활성제 0.001 내지 5 중량%; 및 H)물 잔량을 포함하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치용 어레이 기판의 제조방법에 관한 것이다.

대표도 - 도1



(72) 발명자

윤영진

경기도 수원시 팔달구 화서1동 136-15

이우람

전라북도 익산시 영등동 동신아파트 105동 1202호

특허청구의 범위

청구항 1

- a)기판 상에 게이트 배선을 형성하는 단계;
- b)상기 게이트 배선을 포함한 기판 상에 게이트 절연층을 형성하는 단계;
- c)상기 게이트 절연층 상에 반도체층을 형성하는 단계;
- d)상기 반도체층 상에 소스 및 드레인 전극을 형성하는 단계; 및
- e)상기 드레인 전극에 연결된 화소전극을 형성하는 단계를 포함하는 액정표시장치용 어레이 기판의 제조방법에 있어서,

상기 a)단계는 기판 상에 구리계 금속막을 형성하고 상기 구리계 금속막을 식각액 조성물로 식각하여 게이트 배선을 형성하는 단계를 포함하고,

상기 d)단계는 구리계 금속막을 형성하고 상기 구리계 금속막을 식각액 조성물로 식각하여 소스 및 드레인 전극을 형성하는 단계를 포함하고,

상기 식각액 조성물은, 조성물 총 중량에 대하여 A)과산화수소(H_2O_2) 5 내지 25 중량%, B)유기산 0.1 내지 5 중량%, C)인산염 화합물 0.1 내지 5 중량%, D)수용성 시클릭 아민 화합물 0.1 내지 5 중량%, E)한 분자 내에 질소 원자와 카르복실기를 갖는 수용성 화합물 0.1 내지 5 중량%, F)함불소 화합물 0.01 내지 1.0 중량%, G)다가알코올형 계면활성제 0.001 내지 5 중량%; 및 H)물 잔량을 포함하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치용 어레이 기판의 제조방법.

청구항 2

청구항 1 있어서,

상기 액정표시장치용 어레이 기판이 박막트랜지스터(TFT) 어레이 기판인 것을 특징으로 하는 액정표시장치용 어레이 기판의 제조방법.

청구항 3

조성물 총 중량에 대하여,

- A)과산화수소(H_2O_2) 5 내지 30 중량%;
- B)유기산 0.1 내지 5 중량%;
- C)인산염 화합물 0.1 내지 5 중량%;
- D)수용성 시클릭 아민 화합물 0.1 내지 5 중량%;
- E)한 분자 내에 질소 원자와 카르복실기를 갖는 수용성 화합물 0.1 내지 5 중량%;
- F)함불소 화합물 0.01 내지 1.0 중량%;
- G)다가알콜형 계면활성제 0.001 내지 5 중량%; 및
- H)물 잔량을 포함하는 것을 특징으로 하는 구리계 금속막의 식각액 조성물.

청구항 4

청구항 3에 있어서,

상기 B)유기산은 아세트산(acetic acid), 부탄산(butanoic acid), 시트르산(citric acid), 포름산(formic acid), 글루콘산(gluconic acid), 글리콜산(glycolic acid), 말론산(malonic acid), 펜탄산(pentanoic acid) 및 옥살산(oxalic acid)으로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 또는 2종 이상인 것을 특징으로 하는 구리계 금속막의 식각액 조성물.

청구항 5

청구항 3에 있어서,

상기 C)인산염 화합물은 인산나트륨(sodium phosphate), 인산칼륨(potassium phosphate) 및 인산암모늄(ammonium sulfate)으로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 또는 2종 이상의 것임을 특징으로 하는 구리계 금속막의 식각액 조성물.

청구항 6

청구항 3에 있어서,

상기 D)수용성 시클릭 아민 화합물은 아미노테트라졸(aminotetrazole), 이미다졸(imidazole), 인돌(indole), 푸린(purine), 피라졸(pyrazole), 피리딘(pyridine), 피리미딘(pyrimidine), 피롤(pyrrole), 피롤리딘(pyrrolidine) 및 피롤린(pyrroline)으로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 또는 2종 이상의 것임을 특징으로 하는 구리계 금속막의 식각액 조성물.

청구항 7

청구항 3에 있어서,

상기 E)한 분자 내에 질소원자 및 카르복실기를 가지고 있는 수용성 화합물은 알라닌(alanine), 아미노부티르산(aminobutyric acid), 글루탐산(glutamic acid), 글리신(glycine), 이미노디아세트산(iminodiacetic acid), 니트릴로트리아세트산(nitrilotriacetic acid) 및 사르코신(sarcosine)으로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 또는 2종 이상의 것임을 특징으로 하는 구리계 금속막의 식각액 조성물.

청구항 8

청구항 3에 있어서,

상기 F)함불소 화합물은 NH_4FHF , KFHF , NaFHF , NH_4F , KF , 및 NaF 으로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 또는 2종 이상인 것을 특징으로 하는 구리계 금속막의 식각액 조성물.

청구항 9

청구항 3에 있어서,

상기 G)다가알코올형 계면활성제는 글리세롤(glycerol), 트리에틸렌글리콜(triethylene glycol) 및 폴리에틸렌글리콜(polyethylene glycol)로 이루어진 군에서 선택되는 1종 또는 2종 이상인 것을 특징으로 하는 구리계 금속막의 식각액 조성물.

청구항 10

청구항 3에 있어서,

상기 구리계 금속막은 구리 또는 구리 합금의 단일막, 몰리브덴층과 상기 몰리브덴층 상에 형성된 구리층을 포함하는 구리 몰리브덴막, 또는 몰리브덴합금층과 상기 몰리브덴합금층 상에 형성된 구리층을 포함하는 구리 몰리브덴합금막인 것을 특징으로 하는 구리계 금속막의 식각액 조성물.

청구항 11

I)기관 상에 구리계 금속막을 형성하는 단계;

II)상기 구리계 금속막 상에 선택적으로 광반응 물질을 남기는 단계; 및

III)청구항 3의 기재에 따른 식각액 조성물을 사용하여 상기 구리계 금속막을 식각하는 단계를 포함하는 구리계 금속막의 식각방법.

청구항 12

청구항 11에 있어서,

상기 광반응 물질은 포토레지스트 물질로서, 노광 및 현상 공정에 의해 선택적으로 남겨지는 것임을 특징으로 하는 구리계 금속막의 식각방법.

청구항 13

청구항 11에 있어서,

상기 구리계 금속막은 폴리브덴층과 상기 폴리브덴층 상에 형성된 구리층을 포함하는 구리 폴리브덴막 또는 폴리브덴합금층과 상기 폴리브덴합금층 상에 형성된 구리층을 포함하는 구리 폴리브덴합금막인 것을 특징으로 하는 구리계 금속막의 식각방법.

청구항 14

청구항 3의 기재에 따른 식각액 조성물을 사용하여 식각된 게이트 배선, 소스 전극 및 드레인 전극 중에서 하나 이상을 포함하는 액정표시장치용 어레이 기관.

명세서

발명의 상세한 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 액정표시장치용 어레이 기관의 제조방법, 구리계 금속막의 식각액 조성물, 및 상기 식각액 조성물을 사용하는 구리계 금속막의 식각방법에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 반도체 장치에서 기관 위에 금속 배선을 형성하는 과정은 통상적으로 스퍼터링 등에 의한 금속막 형성공정, 포토레지스트 도포, 노광 및 현상에 의한 선택적인 영역에서의 포토레지스트 형성공정, 및 식각공정에 의한 단계로 구성되고, 개별적인 단위 공정 전후의 세정 공정 등을 포함한다. 이러한 식각공정은 포토레지스트를 마스크로 하여 선택적인 영역에 금속막을 남기는 공정을 의미하며, 통상적으로 플라즈마 등을 이용한 건식식각 또는 식각액 조성물을 이용하는 습식식각이 사용된다.

[0003] 이러한 반도체 장치에서, 최근 금속배선의 저항이 주요한 관심사로 떠오르고 있다. 왜냐하면 저항이 RC 신호지연을 유발하는 주요한 인자이므로, 특히 TFT-LCD(thin film transistor-liquid crystal display)의 경우 패널 크기 증가와 고해상도 실현이 기술개발에 관건이 되고 있기 때문이다. 따라서, TFT-LCD의 대형화에 필수적으로 요구되는 RC 신호지연의 감소를 실현하기 위해서는, 저저항의 물질개발이 필수적이다. 따라서, 종래에 주로 사용되었던 크롬(Cr, 비저항: $12.7 \times 10^{-8} \Omega m$), 폴리브덴(Mo, 비저항: $5 \times 10^{-8} \Omega m$), 알루미늄(Al, 비저항: $2.65 \times 10^{-8} \Omega m$) 및 이들의 합금은 대형 TFT LCD 에 사용되는 게이트 및 데이터 배선 등으로 이용하기 어려운 실정이다.

[0004] 이와 같은 배경하에서, 새로운 저저항 금속막으로서 구리막 및 구리 폴리브덴막 등의 구리계 금속막 및 이의 식각액 조성물에 대한 관심이 높다. 하지만, 구리계 금속막에 대한 식각액 조성물의 경우 현재 여러 종류가 사용되고 있으나, 사용자가 요구하는 성능을 충족시키지 못하고 있는 실정이다.

발명의 내용

해결 하고자하는 과제

[0005] 본 발명의 목적은 구리계 금속막의 식각시 직선성이 우수한 테이퍼프로파일이 형성되는 구리계 금속막의 잔사가 남지 않는 구리계 금속막의 식각액 조성물을 제공하는 것이다. 또한, 본 발명의 목적은 게이트 전극 및 게이트 배선, 소스/드레인 전극 및 데이터 배선의 일괄 식각이 가능한 구리계 금속막의 식각액 조성물을 제공하는 것이다. 또한, 본 발명의 목적은 상기 식각액 조성물을 사용하는 구리계 금속막의 식각방법 및 액정표시장치용 어레이 기관의 제조방법을 제공하는 것이다.

과제 해결수단

[0006] 본 발명은 조성물 총중량에 대하여, A)과산화수소(H_2O_2) 5 내지 30 중량%; B)유기산 0.1 내지 5 중량%; C)인산

염 화합물 0.1 내지 5 중량%; D)수용성 시클릭 아민 화합물 0.1 내지 5 중량%; E)한 분자 내에 질소원자와 카르복실기를 갖는 수용성 화합물 0.1 내지 5 중량%; F)함불소 화합물 0.01 내지 1.0 중량%; G)다가알코올형 계면활성제 0.001 내지 5 중량%; 및 H)물 잔량을 포함하는 구리계 금속막의 식각액 조성물을 제공한다.

[0007] 또한, 본 발명은 I)기판 상에 구리계 금속막을 형성하는 단계; II)상기 구리계 금속막 상에 선택적으로 광반응 물질을 남기는 단계; 및 III)본 발명의 식각액 조성물을 사용하여 상기 구리계 금속막을 식각하는 단계를 포함하는 구리계 금속막의 식각방법을 제공한다.

[0008] 또한, 본 발명은, a)기판 상에 게이트 배선을 형성하는 단계; b)상기 게이트 배선을 포함한 기판 상에 게이트 절연층을 형성하는 단계; c)상기 게이트 절연층 상에 반도체층을 형성하는 단계; d)상기 반도체층 상에 소스 및 드레인 전극을 형성하는 단계; 및 e)상기 드레인 전극에 연결된 화소전극을 형성하는 단계를 포함하는 액정표시장치용 어레이 기판의 제조방법에 있어서, 상기 a)단계는 기판 상에 구리계 금속막을 형성하고 상기 구리계 금속막을 상기 식각액 조성물로 식각하여 게이트 배선을 형성하는 단계를 포함하고, 상기 d)단계는 구리계 금속막을 형성하고 상기 구리계 금속막을 상기 식각액 조성물로 식각하여 소스 및 드레인 전극을 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치용 어레이 기판의 제조방법을 제공한다.

[0009] 또한, 본 발명은 상기 식각액 조성물을 사용하여 식각된 게이트 배선 및 소스/드레인 전극 중 하나 이상을 포함하는 액정표시장치용 어레이 기판을 제공한다.

효 과

[0010] 본 발명에 따른 식각액 조성물은 구리계 금속막을 식각시, 직선성이 우수한 테이퍼프로파일을 구현할 수 있다. 또한, 본 발명에 따른 식각액 조성물로 구리계 금속막을 식각시, 잔사가 발생하지 않아 전기적인 쇼트나 배선의 불량, 휘도의 감소 등의 문제가 발생하지 않는다.

[0011] 또한, 본 발명에 따른 식각액 조성물로 액정표시장치용 어레이 기판을 제조시, 게이트 전극 및 게이트 배선, 소스/드레인 전극 및 데이터 배선을 일괄 식각할 수 있어, 공정이 매우 단순화되어 공정수율을 극대화 할 수 있다.

[0012] 더욱이, 본 발명에 따른 식각액 조성물을 저항이 낮은 구리 또는 구리 합금 배선의 식각에 이용하면, 대화면, 고휘도의 회로를 구현함과 더불어 환경친화적인 액정표시장치용 어레이 기판을 제작할 수 있다.

발명의 실시를 위한 구체적인 내용

[0013] 본 발명은, A)과산화수소(H_2O_2), B)유기산, C)인산염 화합물, D)수용성 시클릭 아민 화합물, E)한 분자 내에 질소원자와 카르복실기를 갖는 수용성 화합물, F)함불소 화합물, G)다가알코올형 계면활성제 및 H) 물을 포함하는 구리계 금속막의 식각액 조성물에 관한 것이다.

[0014] 본 발명에서 구리계 금속막은 막의 구성성분 중에 구리가 포함되는 것으로서, 단일막 및 이중막 등의 다층막을 포함하는 개념이다. 예컨대, 구리 또는 구리 합금의 단일막, 다층막으로서 구리 폴리브덴막, 구리 폴리브덴합금막 등이 포함된다. 상기 구리 폴리브덴막은 폴리브덴층과 상기 폴리브덴층 상에 형성된 구리층을 포함하는 것을 의미하며, 상기 구리 폴리브덴합금막은 폴리브덴합금층과 상기 폴리브덴합금층 상에 형성된 구리층을 포함하는 것을 의미한다. 또한, 상기 폴리브덴합금층은 티타늄(Ti), 탄탈륨(Ta), 크롬(Cr), 니켈(Ni), 네오디뮴(Nd), 및 인듐(In) 등으로 이루어진 군에서 선택되는 하나 이상과 폴리브덴의 합금을 의미한다.

[0015] 본 발명의 식각액 조성물에 포함되는 A)과산화수소(H_2O_2)는 구리계 금속막을 식각하는 주성분이며, 함량은 조성물 총중량에 대하여 5 내지 25중량%이다. 상기 과산화수소의 함량이 5중량% 미만이면 구리계 금속의 식각이 되지 않거나 식각속도가 아주 느려지게 된다. 또한, 상기 A)과산화수소의 함량이 25중량%를 초과할 경우에는 식각속도가 전체적으로 빨라지기 때문에 공정을 컨트롤하는 것이 어려워진다.

[0016] 본 발명의 식각액 조성물에 포함되는 B)유기산은 pH를 적당히 맞추어 주어 식각액의 환경을 구리계 금속막이 식각되기 용이하게 만든다. 상기 B)유기산의 함량은 조성물 총중량에 대하여 0.1 내지 5중량%이다. 상기 B)유기산

의 함량이 0.1 중량% 미만일 경우, pH를 조절하는 영향력이 부족하여 0.5 내지 4.5 정도의 pH 유지가 어려워진다. 또한, 상기 B)유기산의 함량이 5.0중량%를 초과할 경우, 구리의 식각속도가 빨라지고 몰리브덴 또는 몰리브덴합금의 식각속도가 느려짐에 따라 씨디로스(CD Loss)가 커지게 되고 몰리브덴 또는 몰리브덴합금의 잔사가 발생할 가능성이 커지게 된다.

[0017] 상기 B)유기산은 아세트산(acetic acid), 부탄산(butanoic acid), 시트르산(citric acid), 포름산(formic acid), 글루콘산(gluconic acid), 글리콜산(glycolic acid), 말론산(malonic acid) 및 펜탄산(pentanoic acid), 옥살산(oxalic acid)으로 이루어진 군에서 선택되는 1종 또는 2종 이상인 것이 바람직하다.

[0018] 본 발명의 식각액 조성물에 포함되는 C)인산염 화합물은 패턴의 테이퍼 프로파일을 양호하게 만들어주는 성분이다. 만약 상기 C)인산염 화합물이 본 발명의 식각액 조성물에 존재하지 않으면 식각 프로파일이 불량하게 될 수 있다. 상기 C)인산염 화합물의 함량은 조성물 총중량에 대하여 0.1 내지 5중량%이다. 상기 C)인산염 화합물의 함량이 0.1중량% 미만일 경우, 식각 프로파일이 불량하게 될 수 있다. 상기 C)인산염 화합물이 5중량%를 초과하는 경우에는 식각속도가 느려지는 문제가 발생될 수 있다.

[0019] 상기 C)인산염 화합물은 인산에서 수소가 알칼리 금속 혹은 알칼리 토금속으로 하나 또는 두 개 치환된 염에서 선택되는 것이면 특별히 한정하지 않으나, 인산나트륨(sodium phosphate), 인산칼륨(potassium phosphate) 및 인산암모늄(ammonium phosphate)으로 이루어진 군에서 선택되는 1종 또는 2종 이상인 것이 바람직하다.

[0020] 본 발명의 식각액 조성물에 포함되는 D)수용성 시클릭 아민 화합물은 구리게 금속의 식각 속도를 조절하며 패턴의 씨디로스(CD Loss)를 줄여주어 공정상의 마진을 높이는 역할을 한다. 상기 D)수용성 시클릭 아민 화합물의 함량은 조성물 총 중량에 대하여 0.1 내지 5중량%이다. 상기 D)수용성 시클릭 아민 화합물의 함량이 0.1 중량% 미만인 경우, 씨디로스가 너무 크게 발생될 수 있다. 상기 D)수용성 시클릭 아민 화합물의 함량이 5중량%를 초과하는 경우, 구리의 식각속도가 빨라지고 몰리브덴 또는 몰리브덴합금의 식각 속도가 느려지기 때문에 씨디로스가 커지고 몰리브덴 또는 몰리브덴합금의 잔사가 남을 가능성이 증가한다.

[0021] 상기 D)수용성 시클릭 아민 화합물은 아미노테트라졸(aminotetrazole), 이미다졸(imidazole), 인돌(indole), 푸린(purine), 피라졸(pyrazole), 피리딘(pyridine), 피리미딘(pyrimidine), 피롤(pyrrole), 피롤리딘(pyrrolidine) 및 피롤린(pyrroline)으로 이루어진 군에서 선택되는 1종 또는 2종 이상인 것이 바람직하다.

[0022] 본 발명의 식각액 조성물에 포함되는 E)한 분자 내에 질소원자와 카르복실기를 갖는 수용성 화합물은 식각액 조성물의 보관 시 발생할 수 있는 과산화수소수의 자체 분해 반응을 막아주고 많은 수의 기관을 식각할 시에 식각 특성이 변하는 것을 방지한다. 일반적으로 과산화수소수를 사용하는 식각액 조성물의 경우 보관 시 과산화수소수가 자체 분해하여 그 보관기간이 길지가 못하고 용기가 폭발할 수 있는 위험요소까지 갖추고 있다. 그러나 상기 한 분자 내에 질소원자와 카르복실기를 갖는 수용성 화합물이 포함될 경우 과산화수소수의 분해 속도가 10배 가까이 줄어들어 보관기간 및 안정성 확보에 유리하다. 특히 구리층의 경우 식각액 조성물 내에 구리 이온이 다량 잔존할 경우에 패시베이션(passivation) 막을 형성하여 까맣게 산화된 후 더 이상 식각되지 않는 경우가 많이 발생할 수 있으나 이 화합물을 첨가하였을 경우 이런 현상을 막을 수 있다.

[0023] 상기 E)한 분자 내에 질소원자와 카르복실기를 갖는 수용성 화합물의 함량은 0.1 내지 5중량%이다. 상기 E)한 분자 내에 질소원자와 카르복실기를 갖는 수용성 화합물의 함량이 0.1 중량% 미만일 경우, 다량의 기관(약 500매)의 식각 후에는 패시베이션 막이 형성되어 충분한 공정 마진을 얻기가 어려워진다. 또한, 상기 E)한 분자 내에 질소원자와 카르복실기를 갖는 수용성 화합물의 함량이 5.0중량%를 초과할 경우, 구리의 식각속도가 느려지고 몰리브덴 또는 몰리브덴합금의 식각속도는 빨라지므로 구리 몰리브덴막 또는 구리 몰리브덴합금막의 경우 테이퍼 각도가 커지게 된다.

[0024] 상기 E)한 분자 내에 질소원자와 카르복실기를 갖는 수용성 화합물은 알라닌(alanine), 아미노부티르산(aminobutyric acid), 글루탐산(glutamic acid), 글리신(glycine), 이미노디아세트산(iminodiacetic acid), 니트릴로트리아세트산(nitrilotriacetic acid) 및 사르코신(sarcosine)으로 이루어진 군에서 선택되는 1종 또는 2종 이상인 것이 바람직하다.

- [0025] 상기 F)함불소 화합물은 물에 해리되어 F 이온을 낼 수 있는 화합물을 의미한다. 상기 F)함불소 화합물은 구리 막과 몰리브덴 막을 동시에 식각하는 용액에서 필연적으로 발생하게 되는 잔사를 제거하여 주는 역할을 한다. 상기 C)함불소 화합물의 함량은 조성물 총중량에 대하여 0.01 내지 1.0 중량%이다. 상기 C)함불소 화합물의 함량이 0.01 중량% 미만인 경우, 식각 잔사가 발생될 수 있다. 상기 C)함불소 화합물의 함량이 1.0 중량%를 초과하는 경우, 유리 기판 식각율이 크게 발생 되는 단점이 있다.
- [0026] 상기 F)함불소 화합물은 당 업계에서 사용되는 물질이고, 용액 내에서 플루오르 이온 혹은 다원자 플루오르 이온으로 해리될 수 있는 화합물이면 특별히 한정하지 않으나, 불화암모늄(ammonium fluoride), 불화나트륨(sodium fluoride), 불화칼륨(potassium fluoride), 중불화암모늄(ammonium bifluoride), 중불화나트륨(sodium bifluoride) 및 중불화칼륨(potassium bifluoride)으로 이루어진 군에서 선택되는 1종 또는 2종 이상인 것이 바람직하다.
- [0027] 본 발명의 식각액 조성물에 포함되는 G)다가알코올형 계면활성제는 표면장력을 저하시켜 식각의 균일성을 증가시키는 역할을 한다. 또한, 상기 G)다가알코올형 계면활성제는 구리막을 식각한 후 식각액에 녹아져 나오는 구리 이온을 둘러 씌우로서 구리이온의 활동도를 억제하여 과산화수소의 분해 반응을 억제하게 된다. 이렇게 구리 이온의 활동도를 낮추게 되면 식각액을 사용하는 동안 안정적으로 공정을 진행 할 수 있게 된다. 상기 G)다가알코올형 계면활성제의 함량은 조성물 총 중량에 대하여 0.001 내지 5중량%이다. 상기 G)다가알코올형 계면활성제의 함량이 0.001중량% 미만인 경우, 식각 균일성이 저하되고 과산화수소의 분해가 가속화 되는 문제점이 생길 수 있다. 상기 G)다가알코올형 계면활성제의 함량이 5중량% 이상이면 거품이 많이 발생하는 단점이 있다.
- [0028] 상기 G)다가알코올형 계면활성제는 글리세롤(glycerol), 트리에틸렌글리콜(triethylene glycol) 및 폴리에틸렌글리콜(polyethylene glycol)로 이루어진 군에서 선택되는 1종 또는 2종 이상인 것이 바람직하다.
- [0029] 본 발명의 식각액 조성물에 포함되는 H)물은 잔량 포함되고, 이의 종류는 특별히 한정되는 것은 아니나, 탈이온수가 바람직하다. 더욱 바람직하게는 물의 비저항 값(즉, 물속에 이온이 제거된 정도)이 18MΩ/cm이상인 탈이온수를 사용하는 것이 좋다.
- [0030] 본 발명에 따른 식각액 조성물에는 전술한 성분 이외에 통상의 첨가제를 더 첨가할 수 있으며, 첨가제로는 금속 이온 봉쇄제, 및 부식 방지제 등을 사용할 수 있다.
- [0031] 또한, 상기 첨가제는 이에만 한정되는 것이 아니라, 본 발명의 효과를 더욱 양호하게 하기 위하여, 당 업계에 공지되어 있는 여러 다른 첨가제들을 선택하여 첨가할 수도 있다.
- [0032] 본 발명에서 사용되는 A)과산화수소(H_2O_2), B)유기산, C)인산염 화합물, D)수용성 시클릭 아민 화합물, E)한 분자 내에 질소원자와 카르복실기를 갖는 수용성 화합물, F)함불소 화합물, G)다가알코올형 계면활성제는 반도체 공정용의 순도를 가지는 것이 바람직하다.
- [0033] 본 발명에 따른 구리계 금속막의 식각액 조성물은 구리계 금속으로 이루어진 액정표시장치의 게이트 전극 및 게이트 배선, 소스/드레인 전극 및 데이터 배선을 일괄 식각할 수 있다.
- [0034] 또한, 본 발명은,
- [0035] I)기판 상에 구리계 금속막을 형성하는 단계;
- [0036] II)상기 구리계 금속막 상에 선택적으로 광반응 물질을 남기는 단계; 및
- [0037] III)본 발명의 식각액 조성물을 사용하여 상기 구리계 금속막을 식각하는 단계를 포함하는 구리계 금속막의 식각

방법에 관한 것이다.

[0038] 본 발명의 식각방법에서, 상기 광반응 물질은 통상적인 포토레지스트 물질인 것이 바람직하며, 통상적인 노광 및 현상 공정에 의해 선택적으로 남겨질 수 있다.

[0039] 또한, 본 발명은,

[0040] a)기판 상에 게이트 배선을 형성하는 단계;

[0041] b)상기 게이트 배선을 포함한 기판 상에 게이트 절연층을 형성하는 단계;

[0042] c)상기 게이트 절연층 상에 반도체층을 형성하는 단계;

[0043] d)상기 반도체층 상에 소스 및 드레인 전극을 형성하는 단계; 및

[0044] e)상기 드레인 전극에 연결된 화소 전극을 형성하는 단계를 포함하는 액정표시장치용 어레이 기판의 제조방법에 있어서,

[0045] 상기 a)단계는 기판 상에 구리계 금속막을 형성하고 상기 구리계 금속막을 본 발명의 식각액 조성물로 식각하여 게이트 배선을 형성하는 단계를 포함하고,

[0046] 상기 d)단계는 구리계 금속막을 형성하고 상기 구리계 금속막을 본 발명의 식각액 조성물로 식각하여 소스 및 드레인 전극을 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치용 어레이 기판의 제조방법에 관한 것이다.

[0047] 상기 액정표시장치용 어레이 기판은 박막트랜지스터(TFT) 어레이 기판일 수 있다.

[0048] 이하에서 본 발명을 실시예를 통하여 더욱 구체적으로 설명한다. 그러나, 하기의 실시예에 의하여 본 발명의 범위가 제한되는 것은 아니다.

[0049] 실시예1 내지 6: 구리계 금속막의 식각액 조성물의 제조

[0050] 하기 표 1에 나타난 조성에 따라 실시예 1 내지 6의 식각액 조성물을 제조하였다.

표 1

[0051]

	H ₂ O ₂	글리콜산	아미노테트라졸	이미노디아세트산	인산칼륨	불화암모늄	트리에틸렌글리콜	탈이온수
실시예1	5	2	1	0.5	0.5	0.1	1	잔량
실시예2	10	5	1	0.5	0.5	0.2	0.5	잔량
실시예3	13	0.5	0.2	0.5	1	0.1	2	잔량
실시예4	8	1	1	0.5	3	0.2	4	잔량
실시예5	22	2	2	0.5	1	0.3	0.1	잔량
실시예6	25	2	5	1	1	0.5	0.5	잔량

[0052] 시험예: 식각액 조성물의 특성평가

[0053] 실시예1 내지 실시예6의 식각액 조성물을 이용하여 구리계 금속막(Cu 단일막 및 Cu/Mo-Ti 이중막)의 식각공정을 수행하였다. 식각공정 시 식각액 조성물의 온도는 약 30 ℃ 내외로 하였으나, 적정온도는 다른 공정조건과 기타 요인에 의해 필요에 따라 변경할 수 있다. 식각 시간은 식각 온도에 따라서 다를 수 있으나, 통상 30 내지 180 초 정도로 진행한다. 상기 식각공정에서 식각된 구리계 금속막의 프로파일을 단면 SEM (Hitachi사 제품, 모델명 S-4700)을 사용하여 검사하였고, 결과를 표 2에 기재하였다.

표 2

[0054]

	식각속도(Å/sec)		
	Cu 단일막	Cu/Mo-Ti 이중막	
		Cu	Mo
실시예1	40 ~ 60	40 ~ 60	6 ~ 8
실시예2	60 ~ 90	60 ~ 90	5 ~ 8
실시예3	20 ~ 40	20 ~ 40	4 ~ 6
실시예4	40 ~ 60	40 ~ 60	6 ~ 8
실시예5	50 ~ 80	50 ~ 80	6 ~ 8
실시예6	70 ~ 90	70 ~ 90	6 ~ 8

[0055]

표 2를 참조하면, 실시예1 내지 실시예6의 식각속도는 적당한 것으로 확인되었다. 또한, 도 1 및 도 2에서 확인할 수 있는 바와 같이, 실시예1에 따른 식각액 조성물로 식각한 구리막은 양호한 식각 프로파일을 나타내었으며, 도 3에서 확인할 수 있는 바와 같이, 실시예1에 따른 식각액 조성물로 구리막을 식각 한 경우, 식각 잔사가 남지 않았다.

[0056]

따라서, 본 발명의 식각액 조성물은 구리계 금속막의 우수한 테이퍼프로파일, 패턴의 직선성, 적당한 식각 속도를 제공하며, 특히, 식각 후 잔사가 전혀 남지 않는 특성을 가짐을 알 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0057]

도 1은 본 발명의 실시예1에 따른 식각액 조성물을 이용하여 Cu/Mo-Ti 막을 식각한 후, 식각 단면을 관찰한 주사전자현미경 사진이고,

[0058]

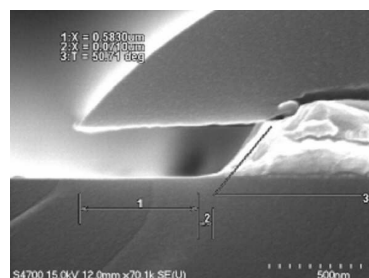
도 2는 본 발명의 실시예1에 따른 식각액 조성물을 이용하여 Cu/Mo-Ti 막을 을 식각한 후, 전체적인 식각 프로파일을 관찰한 주사전자현미경 사진이고

[0059]

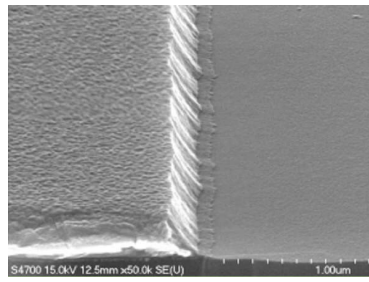
도 3은 본 발명의 실시예1에 따른 식각액 조성물을 이용하여 Cu/Mo-Ti 막을 을 식각한 후, 식각 잔사가 남지 않음을 확인하기 위해 구리 배선 주변 표면을 관찰한 전자주사현미경 사진이다.

도면

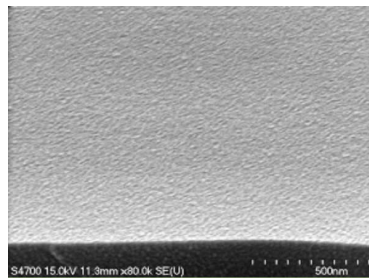
도면1



도면2



도면3



专利名称(译)	制造用于液晶显示器的阵列基板的方法		
公开(公告)号	KR1020100090538A	公开(公告)日	2010-08-16
申请号	KR1020090009879	申请日	2009-02-06
[标]申请(专利权)人(译)	东友精细化工有限公司		
申请(专利权)人(译)	DONGWOO FINE-CHEM CO. , LTD. DONGWOO FINE CHEM CO. , LTD.		
当前申请(专利权)人(译)	DONGWOO FINE CHEM CO. , LTD.		
[标]发明人	CHOI YONG SUK LEE SUK YOON YOUNG JIN LEE WOO RAM		
发明人	CHOI, YONG SUK LEE, SUK YOON, YOUNG JIN LEE, WOO RAM		
IPC分类号	G02F1/133 H01L29/786		
代理人(译)	汉阳专利事务所		
其他公开文献	KR101529733B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本发明提供一种制造半导体器件的方法，包括：a) 在衬底上形成栅极布线；b) 在包括栅极布线的基板上形成栅极绝缘层；c) 在栅极绝缘层上形成半导体层；d) 在半导体层上形成源极和漏极；并且形成连接到漏电极的像素电极，其中步骤a) 包括以下步骤：在基板上形成铜基金属膜并在蚀刻剂组合物上形成铜基金属膜通过用蚀刻剂组合物蚀刻铜基金属膜形成栅极布线，形成源极和漏极，其中蚀刻剂组合物包括：(B) 0.1至5%重量的有机酸，(C) 0.1至5%重量的磷酸盐化合物，(D) 0.1至5%重量的水溶性环胺化合物，(E) 0.1至5重量%的在一个分子中具有氮原子和羧基的水溶性化合物，(F) 0.01至1.0重量%的氟化合物，(G) 0.001至5%的多元醇型表面活性剂%；(H) 剩余水量技术领域本发明涉及一种制造用于液晶显示器的阵列基板的方法。

